# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ»

Институт системной и программной инженерии и информационных технологий (СПИНТех)

#### Отчёт

по дисциплине «Электроника»

Лабораторная работа №2 «Исследование усилительных элементов»

Руководител	ТЬ
	_ Жмылев В. А.
«»	2023 г.
Студент гру	ппы ПИН-23
	_ Исламов Р. Р.
// \\\	2023 г

Москва

2023

#### Цель работы

Исследование биполярных и полевых транзисторов.

#### Задание 1 Построение семейства выходных ВАХ

$$E = 8.61 \, B$$

Uкэ, В	0.3	1	3	5	7	10
I <sub>к1</sub> (при I <sub>Б1</sub> ), мА	0.813	0.874	1.05	1.217	1.395	1.647
I <sub>к2</sub> (при I <sub>Б2</sub> ), мА	1.21	1.3	1.564	1.812	2.077	2.453
I <sub>к3</sub> (при I <sub>Б3</sub> ), мА	1.897	2.039	2.439	2.845	3.243	3.851
I <sub>к4</sub> (при I <sub>Б4</sub> ), мА	3.325	3.574	4.286	4.989	5.699	6.758
<b>I</b> к5(при <b>I</b> Б5), мА	7.801	8.389	10.051	11.717	13.376	15.877

IB IB1 IB2 IB3 IB4 IB5
I, mA 0.01 0.015 0.02 0.04 0.09

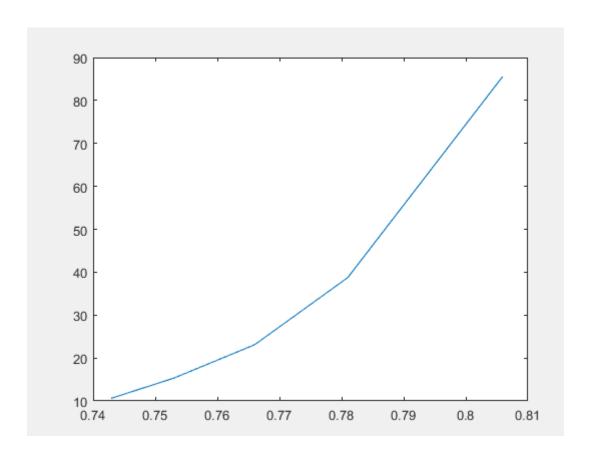
## Задание 2 Расчет коэффициента усиления и выходного сопротивления

$$B = \frac{dIk}{dI6} = \frac{4.989 - 2.845}{0.04 - 0.02} = 107.2$$

$$R = \frac{5 - 3}{2.845 - 2.439} = 4.926$$

## Задание 3 Построение входной ВАХ

Іь	$I_{61}$	$I_{62}$	$I_{E3}$	I <sub>64</sub>	$I_{55}$
Іь, мкА	10.658	15.321	23.093	38.747	85.709
U <sub>Б</sub> э, В	0.743	0.753	0.766	0.781	0.806



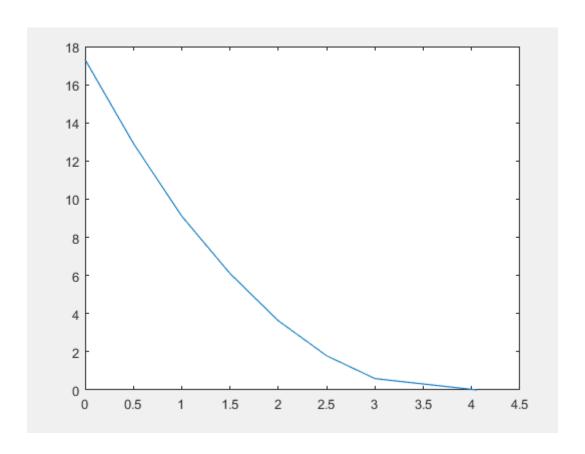
Задание 4 Расчет входного сопротивления

$$R = \frac{dU 69}{dI6} = \frac{0.753 - 0,743}{15.321 - 10.658} * 10^3 = 2.145$$

## Задание 5 Построение стоко-затворной характеристики

$$E = 12.162$$

U <sub>3И</sub> , В	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	U <sub>OTC</sub> =4.054
Ic, mA	I <sub>C.HAC</sub> =17.	12.923	9.113	6.1	3.626	1.791	0.594	$I_C = 0$



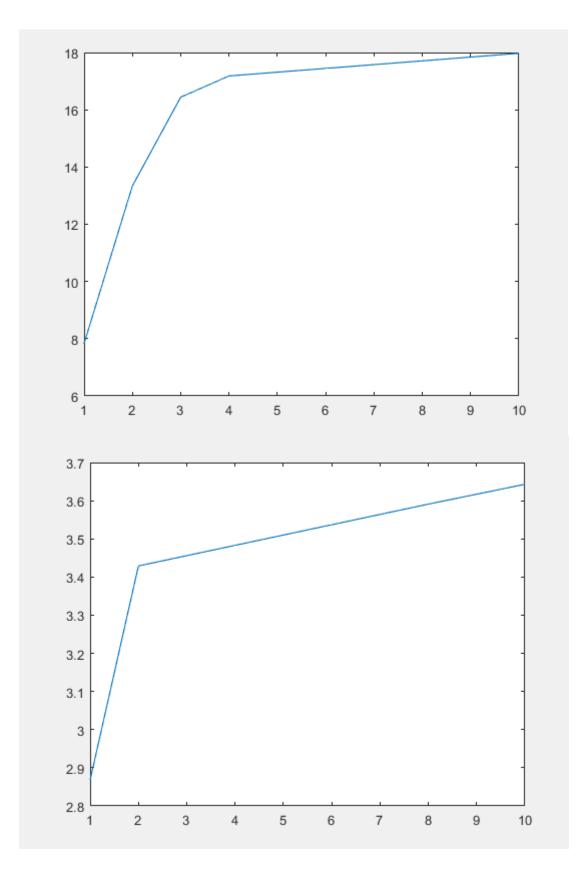
# Задание 6 Расчет крутизны

$$S = \frac{dIc}{dU$$
зи  $= \frac{12.923 - 9.113}{1 - 0.5} = 7.62$ 

# Задание 7 Построение стоковой ВАХ

$$U$$
зи =  $\frac{4.054}{2}$  = 2.027

<b>U</b> <sub>СИ</sub> , <b>B</b>	1	2	3	4	6	8	10
Iс.изи = 0, мА	7.834	13.339	16.441	17.182	17.446	17.709	17.973
$I_{\text{C.U3H}} = 2.027$ , мА	2.868	3.429	3.456	3.483	3.537	3.591	3.643



#### Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил особенности биполярных и полевых транзисторов, провел эксперименты по построению их вольт-амперных характеристик (ВАХ), а также получил график стокозатворной характеристики полевого транзистора.